染料敏化纳米 ZnO 薄膜太阳电池机理初探*

曾隆月1) 戴松元1) 王孔嘉1) 史成武12) 孔凡太1) 胡林华1) 潘 旭1)

¹(中国科学院等离子体物理研究所,合肥 230031) ²(合肥工业大学,合肥 230009)

(2004年2月13日收到2004年4月12日收到修改稿)

讨论利用 ZnO 代替 TiO₂ 作为光阳极制作染料敏化薄膜太阳电池的可行性. 使用 LSV 法, IR 光谱和 UV-vis 光谱 探讨了电池的工作机理和性能,并与染料敏化纳米 TiO₂薄膜太阳电池作了比较. 结果发现 ZnO 薄膜表面与染料的 吸附键合力太弱是导致 ZnO 太阳电池效率低下的主要原因.

关键词:纳米 ZnO,太阳电池,染料敏化,量子效率 PACC:2852F,8630J,8250C

1.引 言

自从 1991 年 Gräztel 等报道染料敏化纳米多孔 TiO₂薄膜制成的太阳电池(TiO₂电池)效率达到 7.1%以来^[1],世界各国科学家对它进行了广泛的研 究.这些研究取得了很大的进展,在 1993 年,Gräztel 等人合成了红色染料 Ru $L_2 X_2$ (L = 2.2'-bipyridine-4, 4'-dicarboxylate, X = Cl, Br, I),获得了 10% 的效 率^[2].在 2001 年又有了新的突破,同样是来自 Gräztel 小组的报道:使用黑色染料 {($C_4 H_9$), N }[Ru (H_2 teterpy { NCS },],teterpy = 4 A' A''-tricarboxy-2,2': 6',2''-terpyridine } 敏化的 TiO₂ 电池,效率达到了 10.4%^[3].

在现阶段,人们一方面对薄膜进行优化^[4-6],另 一方面,探索其他宽禁带纳米半导体薄膜取代 TiO₂ 薄膜.在积极寻求其他可代替 TiO₂作为光阳极的半 导体材料中,已经有人制备出了染料敏化纳米 Fe₂O₃ SnO₂和 WO₃薄膜太阳电池⁷⁻⁹⁻¹,然而它们的 效率与 TiO₂电池的相比要低很多.

从材料特性上看,ZnO 是最有希望取代 TiO₂的 半导体材料.ZnO 和 TiO₂均为宽禁带半导体材料, 导带电位相差很小,都位于染料的 LUMO 之下,所以 染料的光激发电子都能够注入到 TiO₂导带上去¹⁰], 电子在 ZnO 中有较大的迁移率^[11],有望减小电子在 薄膜中的传输时间,且纳米 ZnO 的制备要比 TiO₂简 单得多,可以进一步降低电池成本.

早在 1994 年 Redmond 和 Gräztel 等就报道了效 率为 0.4%的染料敏化纳米多孔 ZnO 薄膜太阳电池 (ZnO 电池)^{12]}.此后,ZnO 电池逐渐引起了人们的 兴趣,对它的研究有所增加^[13,14].在 1997 年 Bedja 等报道了效率为 1.2%的 ZnO 电池^[15].

我们实验室使用溶胶-凝胶方法制备了纳米 ZnO,采用丝网印刷制备了 ZnO 多孔薄膜,以它作为 光阳极制作了 ZnO 电池,电池效率达到了 2.22%. 并利用红外光谱仪和紫外可见分光光度计等研究工 具,探讨和解释了 ZnO 电池效率低下的主要原因.

2. 实 验

2.1. 纳米 ZnO 的制备

纳米 ZnO 的具体制作方法见文献 16]或 17], XRD 分析表明使用此种方法制作的纳米 ZnO 全为 纤锌矿(wurtzite)结构,不含杂质. 经过 BET 测试,它 的比表面积为 87m²/g. TEM 观察表明纳米 ZnO 基本 上显球形,颗粒直径为 30nm. ZnO 的这些性质表明 它适合用于制备纳米多孔 ZnO 薄膜.

^{*}国家重点基础研究规划项目(批准号:G2000028206)资助的课题.

[†]E-mail :sydai@ipp.ac.cn

2.2.ZnO 电池的制作

2.3. 表征方法

电池 *LV* 特性测试:标准光源(氙灯 ,300SQ ,中 国科学院长春光机所制造) 数字源表(Keithley 2420),Testpoint 伏安特性测试软件对 ZnO 电池的性 能进行了测量.

电池电化学特性测试:为了了解电子在 ZnO 膜的传输情况,在无光照条件下,利用电化学工作站(CHI660A,CH Instrument Co. USA)测量了 ZnO 电池的 LSV(线性扫描伏安法)特性.其中,以光阳极(即半导体电极 TCO)作为工作电极,反电极(TCO/Pt)作为对电极和参比电极,见图 1.



图1 电化学特性测试示意图

吸收光谱测试:在 ZnO 薄膜吸附了染料之后 (记为 dye/ZnO),分别利用傅里叶变换红外光谱仪 (MAGNA-IR 750, Nicolet Instrument Co. USA)和双光 束紫外可见分光光度计(UV-vis TU-1901,北京普析 通用仪器有限责任公司)测量了 dye/ZnO 的吸收光 谱.分别简称为 IR 光谱和 UV-vis 光谱.

作为对比,我们也测量了电解质、薄膜厚度及孔 洞率基本相近的 TiO₂电池的相关特性.

3. 实验结果

图 2 为在暗室中测量的 ZnO 和 TiO₂电池的 LSV 曲线.在一定电势下,在电解质/半导体薄膜和电解 质/镀铂反电极的界面处分别发生如下反应 $3I^{-} - 2e = I_{3}^{-}$, $I_{3}^{-} + 2e = 3I^{-}$.也就是 I⁻ 失去电子并通过 半导体薄膜传输到光阳极,而 I_{3}^{-} 运动到反电极后, 在铂的催化下,被还原成 I⁻.在相同的正偏压下, ZnO 电池的电流要比 TiO₂电池的大,而在相同的负 偏压下的情况正好相反.



图 2 在无光照条件下, 电池的 LSV 曲线

图 3 为染料分子中羧基[- COO⁻]的 IR 光谱. 吸附在 TiO₂和 ZnO 薄膜上的羧基都向大波数方向 有不同程度的位移 [- COO - Ti -]的吸收峰的位 置比[- COO - Zn -]的大 19cm⁻¹.



图 3 IR 光谱

图 4 为 dye/ZnO 和 dye/TiO₂的 UV-vis 光谱. dye/ TiO₂的吸收系数比 dye/ZnO 的明显要大 :在可见光范 围内 $_{dye/TiO_2}$ 的吸收峰值位置与 $_{dye/ZnO}$ 的相比红 移 $_{12nm.}$



图 4 太阳光谱和 dye/ZnO 及 dye/TiO2的 UV-vis 光谱

图 5 为 TiO₂电池和 ZnO 电池的 *I-V* 曲线图.由 图可算出 TiO₂电池和 ZnO 电池的填充因子 FF 分别 为 63%和 61%.总的效率分别为 5.34%和 2.22%.



图 5 染料敏化 ZnO 太阳电池的 LV 曲线

4. 讨论

在波长为 λ 的单色光照射下,染料敏化薄膜太 阳电池(DSCs)的光电转换效率(IPCE)

Eff(λ) = LHE(λ) $\phi_{inj}\eta_e$, (1) 其中 LHE(λ)为被染料吸收的太阳光与总的入射光 强之比,它主要取决于染料的性质和薄膜中吸附染 料数量的多少; ϕ_{inj} 为量子效率,即染料的激发电子 注入到氧化物导带上的概率; η_e 为收集效率,也就 是在导带中的电子通过氧化膜到达正电极的 概率^[19].

从图 2 电化学测试结果可以看出:在相同的正 偏压下 ZnO 电池的电流要比 TiO, 电池的大 ,而在相 同的负偏压下的情况正好相反. 这意味着纳米多孔 ZnO 薄膜比 TiO, 更加有利于电子传输, ZnO 的暗电 流特性优于 TiO, 使得 ZnO 的收集效率 η_e 大于 TiO, 的 η_{c} . 我们的实验结果与 Jongh 和 John 的一 致^[21,14], Jongh 利用 IMPS(光强调制光电流谱)技术, 测出电子穿过 0.35μm 多孔纳米 ZnO 薄膜的时间小 于 10ms,而穿过 1.0 μ m 的 TiO₂薄膜则要达到 1.0s. Meulenkamp 测出电子在 ZnO 中移迁率比在 TiO,中 的大.研究表明^{5 20]}:在TiO,薄膜中存在着大量的表 面态 表面态能级位于禁带之中(如图1所示的S), 是局域的 这些局域态构成陷阱 束缚了电子在薄膜 中的运动 ,只有具备一定热能的电子才能脱离陷阱 的束缚,从而传输出去,这使得电子在 TiO2薄膜中的 传输时间增长. 多孔纳米 ZnO 薄膜的表面态显著小 于 TiO,的表面态,所以,电子在其中的传输速率较 TiO,的大,暗电流特性好. Morrison 等观察到 ZnO 中 的电子是通过它的导带直接与溶液中的受主复合, 而不是通过表面态或者是其他的杂质能级²⁰²²这 也从侧面上证实了 ZnO 中的表面态较少. 总之 从 电子在薄膜中的传输方面上来看,ZnO薄膜优于 TiO,薄膜 能产生较大的 η_{e} .

然而,日前我们做出的 ZnO 电池的效率仅为 2.22% 远小于在同等条件下 TiO₂电池 5.34% 的效 率.这主要是由于染料吸收太阳光之后,染料分子 中处于激发态的电子无法有效注入 ZnO 的导带,即 ZnO 电池的量子效率 *∮*ini 低.

电子注入量子效率 🖣 📊 ,可表示为

$$\phi_{\rm inj} = \frac{k_{\rm inj}}{k_{\rm r} + k_{\rm nr} + k_{\rm inj}} , \qquad (2)$$

 k_r 和 k_m 分别为染料激发态的辐射和非辐射衰减速率常数 k_m 为电子注入导带的速率常数 . 当染料分子与半导体表面的相互作用很强时 ,电子注入 速率 k_m ,即界面间电荷转移速率 k_n 为^[2]

$$k_{\rm ct} = 2\pi |V|^2 \rho / h , \qquad (3)$$

其中 V 为染料与半导体表面电子的键合强度 , ρ 是 电子态的密度 ,h 是 Planck 常数. 从(3)式可以看出 电子键合强度对电子注入速率起决定作用. 事实 上 ,在 TiO₂电池中 ,由于 TiO₂中 Ti 的 3d 轨道和染料 中配体电子激发态 π^* 轨道有着很好的电子键合 ,这 种键合有效地加强了染料激发态 π^* 轨道上电子的 离域作用,使得电子能很快地从染料激发态注入 TiO₂导带^[2]因而,它的量子效率 ϕ_{ini} 接近 100%.

由图 3 可以看出 [- COO -] [- COO - Zn -] 和 - COO - Ti - 吸收峰的位置分别为 1609,1615 和 1634 cm⁻¹. 吸附在 TiO₂和 ZnO 薄膜上的羧基的吸 收峰位置都向大波数方向有不同程度的位移, [-COO-Ti-]的吸收峰的位置要比 M-COO-Zn -]的大 19cm⁻¹,这有力的证明了染料与 ZnO 的键 合强度 V 小于与 TiO₂ 的键合强度. 由(2)(3)式分 析可知 :染料与 ZnO 键合强度的减弱导致电子注入 速率 kini的减小 ,从而 ,使得它的量子效率 øini低下. 染料与 ZnO 键合强度之所以小于与 TiO2 的键合强 度 是由于 Zn²⁺ 的电负性大于处于任一价位上的 Ti 电负性大的 Zn²⁺ 在与染料分子中的 - COO -] 的结合成[-COO-Zn-]键时,它的键能小于[-COO - Ti - 的键能. 这个实验结果与 Anderson 等人 的一致,他们利用瞬态红外光谱(transient IR spectroscopy)直接测出电子注入 ZnO 导带的时间要 比注入 TiO,的时间至少大一个数量级[23].

图 4 的 UV-vis 光谱进一步证明了染料分子与 ZnO 表面的键合强度弱于与 TiO₂的键合强度 ,从而 导致染料分子的金属到配体的电荷转移(MLCT)吸 收峰的蓝移.表明染料中钌原子的 4d 轨道与其配 体的反键轨道 π* 之间能隙变大,不利于激发的电子 通过 4d—π* 转移注入到 ZnO 导带,使 ZnO 电池的量 子效率 φ_{inj}降低. 另外,当波长小于 450nm 时,太阳 光光强急剧减小,吸收峰蓝移后,对太阳光的吸收减 弱,这也使得 ZnO 电池效率降低.

从图 4 还可以看出 dye/TiO_2 的吸收系数 LHE(λ)大于 dye/ZnO 的 LHE(λ);若定义总的吸收 系数为 :LHE = $\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} LHE(\lambda) d\lambda$. 按图 4 计算 ,从波长 340nm 到 850nm ,ZnO 的LHE 仅为TiO_2 的三分之二. 在 TiO_2/ZnO 薄膜参数(膜厚与孔洞率)基本相同的 情况下 ,由于染料与 ZnO 键合较弱 ,使 ZnO 薄膜吸 附的染料数量减少 ,导致 ZnO 的 LHE(λ)比 TiO_2 的 小 ,这也是 ZnO 电池效率低下的主要原因之一.

5.结 论

在 DSCs 应用上,虽然纳米多孔 ZnO 薄膜具有 电子传输上的优势,然而由于它的量子效率 ϕ_{inj} 较 低,使得整个电池的光电转换效率不高.除非能够 提高它的量子效率 ϕ_{inj} ,否则,纳米多孔 ZnO 薄膜不 可能成为一种理想的薄膜太阳电池材料.

- [1] O'Regan B and Gräztel M 1991 Nature 353 737
- [2] Nazeeruddin M K, Kay A, Rodicio I and Humphry-Baker R 1993
 J. Am. Chem. Soc. 115 6382
- [3] Mohammad K et al 2001 J. Am. Chem. Soc 123 1613
- [4] Dai S Y and Wang K J 2003 Chin. Phys. Lett. 20 953
- [5] Hu L H, Dai S Y and Wang K J 2003 Acta Phys. Sin. 52 2135 (in Chinese) [胡林华、戴松元、王孔嘉 2003 物理学报 52 2135]
- [6] Huang H, Luo H J and Jie Y X 2002 Acta Phys. Sin. 51 1881 (in Chinese)[黄 晖、罗宏杰、姚 喜 2002 物理学报 51 1881]
- [7] Björksten U, Moser J and Gräztel M 1994 Chem. Mater 6 858
- [8] Bedja I , Hotchandani S and Kamat P V 1994 J. Phys. Chem. A 98 4133
- [9] Santato C , Odziemkowski M and Ulmann M 2001 J. Am. Chem. Soc. 123 10639
- [10] Bauer C , Boschloo G and Hagfeldt A 2001 J. Phys. Chem. B 26 5585
- [11] Anders H and Gräztel M 1999 J. Phys Chem. B 103 7831
- [12] Redmond G , Fitzmaurice D and Gräztel M 1994 Chem. Mater. 6 686
- [13] Rensmo H et al 1997 J. Phys. Chem. B 101 2598

- [14] John B A, Yong Q W and Tianquan L 1991 J. Phys. Chem. B 103 6643
- [15] Bedja I et al 1997 Langmuir 13 2398
- [16] Zeng L Y, Si C W, Dai S Y and Wang K J 2004 Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences 21 393 (in Chinese I 曾隆月、史成武、戴松元、王孔嘉 2004 中科院研究 生院学报 21 393]
- [17] Yang X J, Shi C S and Xu X L 2002 Acta Phys. Sin. 51 2871 (in Chinese)[杨秀键、施朝淑、许小亮 2002 物理学报 51 2871]
- [18] Zakeeruddin S M, Liska P and Gräztel M 2003 Chem. Mater. 15 1825
- [19] Gräztel M 1995 Proc Indian Acad. Sci. 6 607
- [20] Morrison S R 1980 Electrochemistry at Semiconductors and Oxidized Metal Electrodes (New York : Plenum Press) p 193
- [21] de Jongh P E and Vanmaekelbergh D 1996 J. Phys. R. Lett. 77 3427
- [22] Lanzafame J M, Palese S, Wang D, Miller R J D and Muenter A A 1994 J. Phys. Chem. 98 11020
- [23] Anderson N A et al 2003 J. Phys. Chem. B 107 14414

Zeng Long-Yue¹) Dai Song-Yuan¹[†] Wang Kong-Jia¹

Shi Cheng-Wu¹⁽²⁾ Kong Fan-Tai¹⁾ Hu Lin-Hua¹⁾ Pan Xu¹⁾

¹ (Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China) ² (Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

(Received 13 February 2004; revised manuscript received 12 April 2004)

Abstract

This paper discusses the possibility of using nanocrystalline ZnO films as photo-electrode in dye-sensitized solar cells (DSCs). The performances and mechanism of DSCs based on ZnO nanoporous film are observed by using IR, UV-vis spectra and LSV method, and compared with dye-sensitized solar cells based on nanocrystalline TiO₂ films. It is found that the low efficiency of DSCs based on ZnO is due to the poor binding force between the surface of nanocrystalline ZnO films and the Ru L_2 (NCS) (L = 2 2'-bipydyl-4 A'-dicarboxylate) dye.

Keywords : nanocrystalline ZnO , solar cell , dye-sensitized , quantum yield PACC : 2852F , 8630J , 8250C

^{*} Project supported by the National Key Basic Research Special Foundation of China on Photovoltaic Cell (Grant No. G2000028206).

[†]E-mail <code>`sydai@ipp.ac.cn</code>